

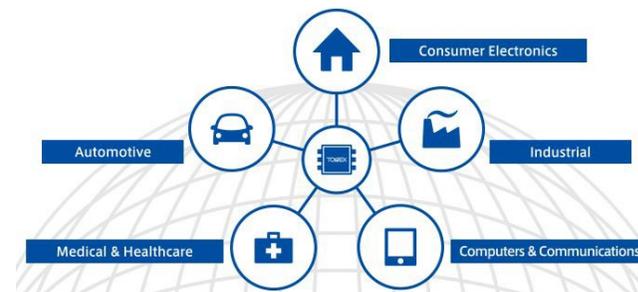
2026年3月期 第1四半期 決算説明資料

2025年 8月12日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2026年3月期 第1四半期業績

2

2026年3月期 業績予想

3

株主還元

4

トピックス

Appendix

▶ **トレックスは、日本市場と北米市場の売上は回復したが、
為替の影響と原価上昇の影響により、増収減益**

▶ **フェニテックは、アジア市場は回復するも、北米市場の
売上が大きく減少し、減収減益**

▶ **2026年3月期の業績予想は、期初の予想から変更なし**

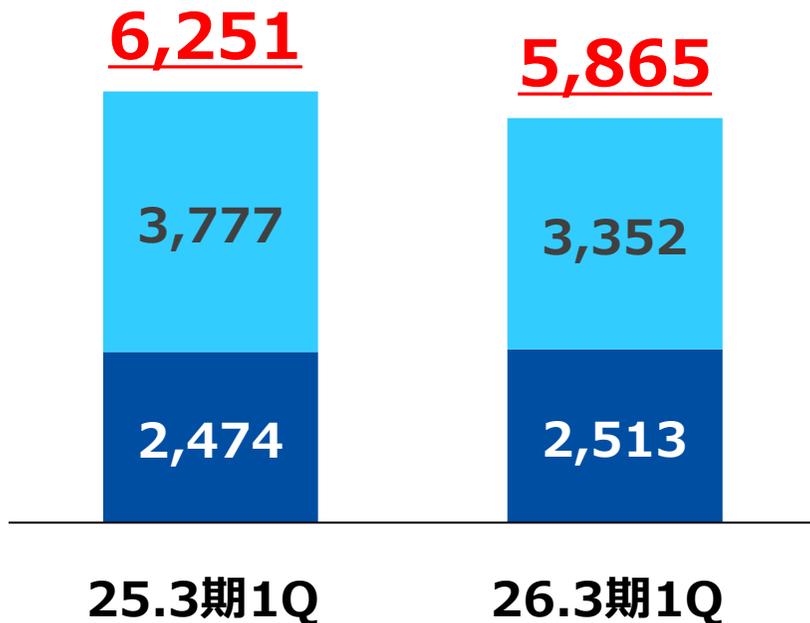
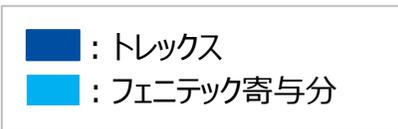
2026年3月期 第1四半期業績

(単位：百万円)

	25.3期 1Q実績	26.3期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	6,251	5,865	▲6.2%
営業利益	365	165	▲54.8%
営業利益率	5.8%	2.8%	▲3pt
経常利益	340	64	▲81.1%
親会社株主に 帰属する四半期純利益	83	35	▲56.9%
EPS (円)	7.57	3.38	▲4.19
海外売上高比率 (*1)	70.6%	70.6%	±0pt
平均為替レート (1\$=)	¥156.5	¥145.1	-
減価償却費	498	486	▲2.4%
設備投資	1,221	341	▲72.1%

(*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 日本市場と北米市場が回復し若干の増収
- 産業機器分野と医療機器分野が増加

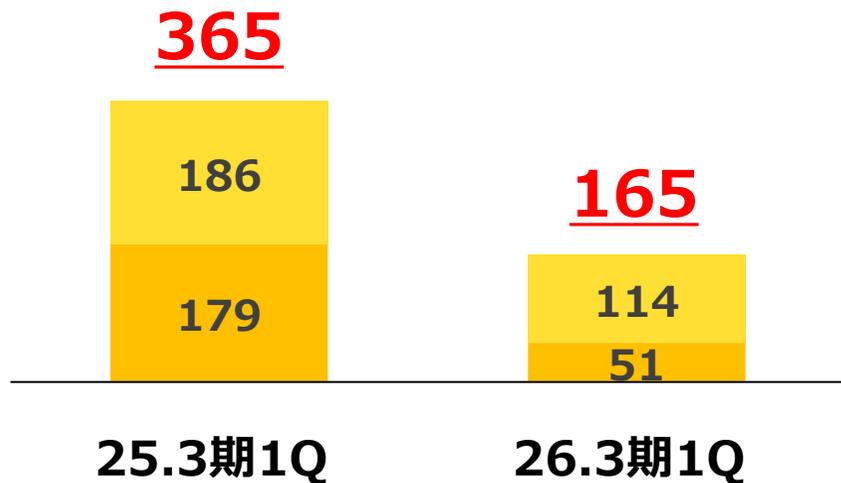
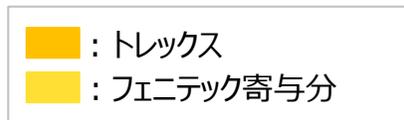
➤ フェニテック

- 北米市場の減少に伴い、減収
- 産業機器分野が減少

(単位：百万円)

	25.3期1Q 実績	26.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
売上高	6,251	5,865	▲6.2%

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 為替の影響と原価の上昇により減益

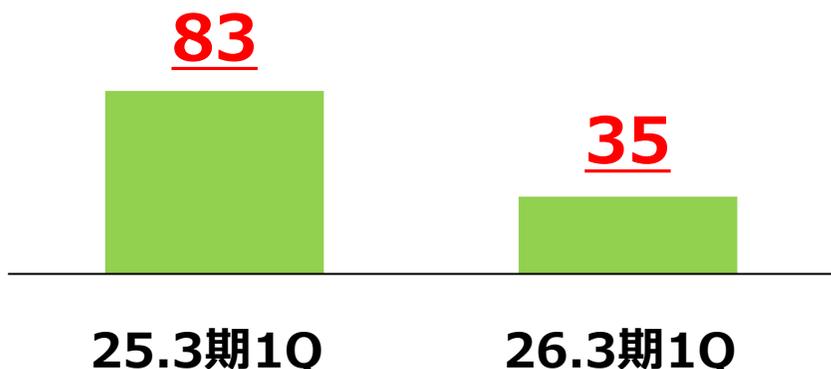
➤ フェニテック

- 売上の減少に伴い減益

(単位：百万円)

	25.3期1Q 実績	26.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
営業利益	365	165	▲54.8%

(単位：百万円)



営業利益の減少と、為替差損の増加により、減少

(単位：百万円)

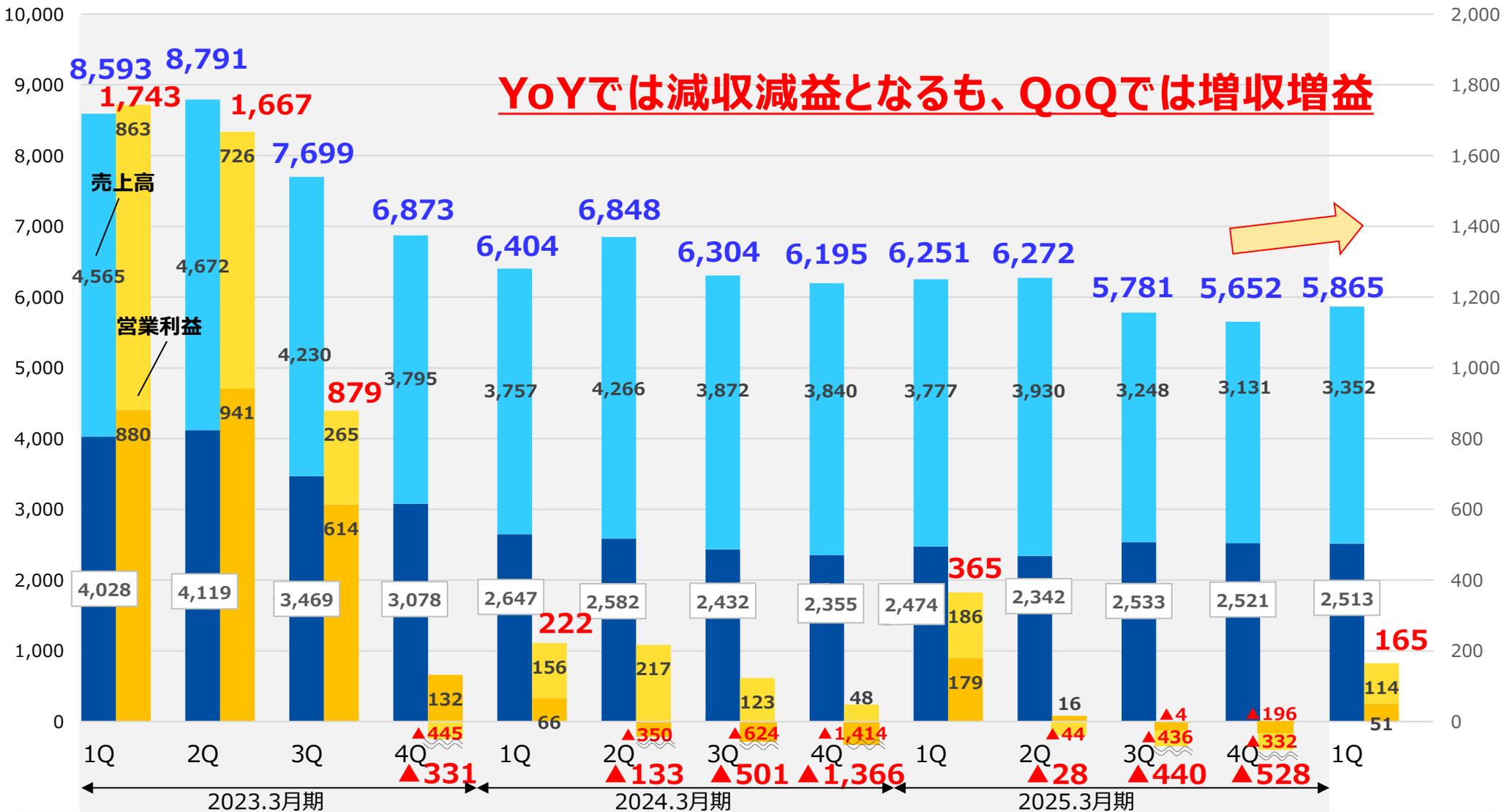
	25.3期1Q 実績	26.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
四半期純利益	70	35	▲56.9%

売上高・営業利益の四半期推移



(左軸：売上高) トレックス : ■ ■
 (単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)
 (単位：百万円)



(単位：百万円)

	25年3月期末	26年3月期 1Q末	対前期末増減
資産	33,607	33,513	▲94
負債	16,207	16,544	337
純資産	17,400	16,969	▲431

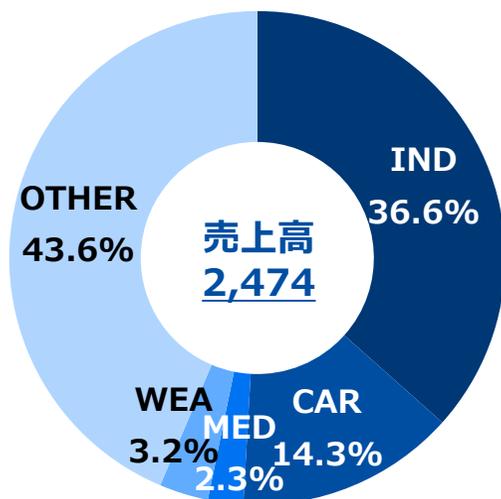
<参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

	25年3月期末	26年3月期 1Q末	対前期末増減
有利子負債	12,984	13,755	771
自己資本比率	51.8%	50.6%	▲1.2pt
D/Eレシオ	0.74	0.81	0.07pt

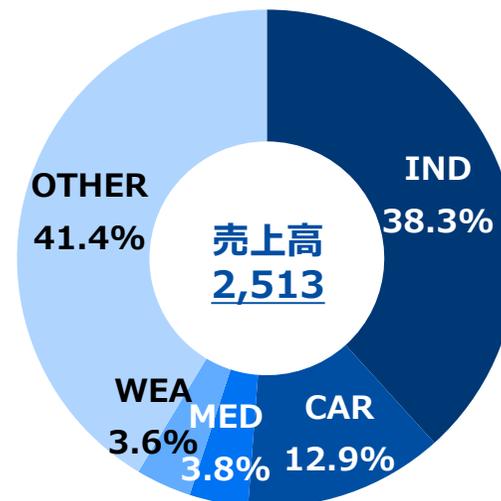
トレックス／フェニテック 各単体

2026年3月期 第1四半期業績 ～アプリケーション別売上高（トレックス）：参考値

TOIREX



25.3期 1Q実績



26.3期 1Q実績

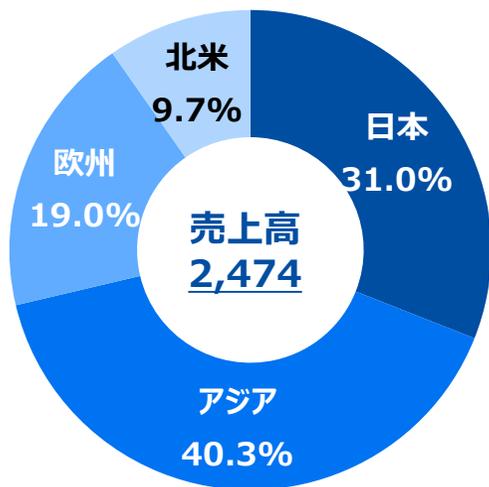
(単位：百万円)

アプリケーション	25.3期 1Q		26.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	905	36.6%	963	38.3%	6.4%
CAR 車載機器	355	14.3%	325	12.9%	▲8.5%
MED 医療機器	56	2.3%	95	3.8%	69.6%
WEA ウェアラブル機器	78	3.2%	90	3.6%	15.4%
OTHER その他機器	1,080	43.6%	1,040	41.4%	▲3.7%

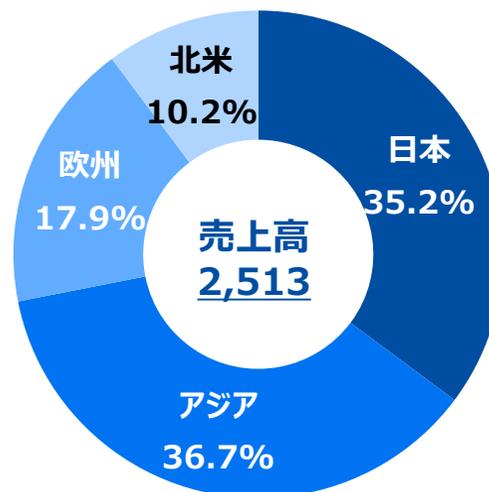
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2026年3月期 第1四半期業績 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



25.3期 1Q実績

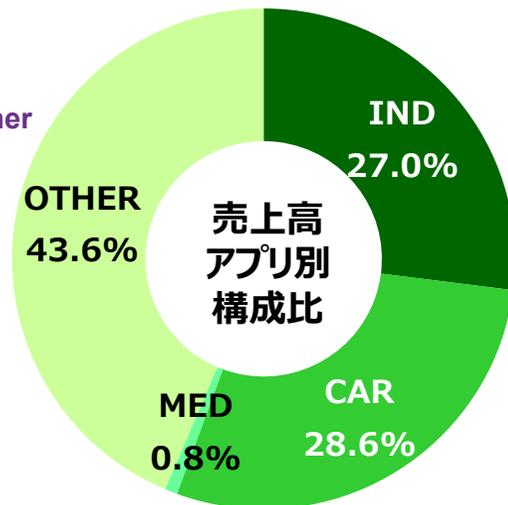


26.3期 1Q実績

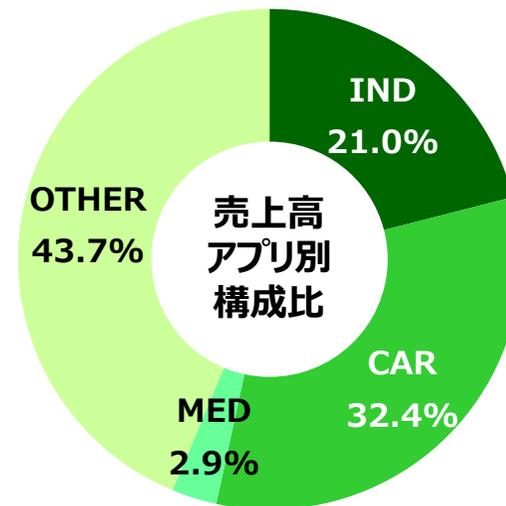
(単位：百万円)

地域 (D-in)	25.3期 1Q		26.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	767	31.0%	885	35.2%	15.4%
アジア	997	40.3%	921	36.7%	▲7.6%
欧州	470	19.0%	451	17.9%	▲4.0%
北米	240	9.7%	256	10.2%	6.7%
平均為替レート (1\$=)	156.5円		145.1円		

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



25.3期 1Q実績



26.3期 1Q実績

(単位：百万円)

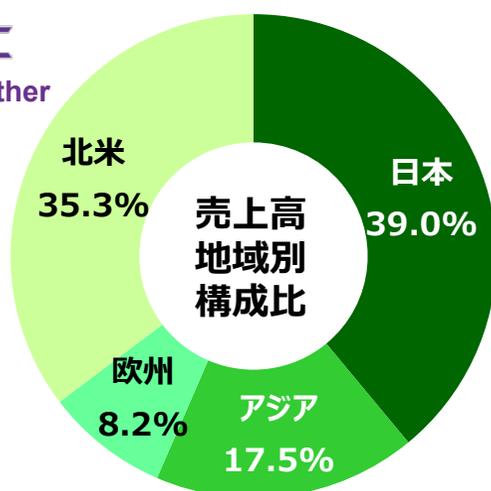
アプリケーション	25.3期 1Q		26.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	1,097	27%	796	21.0%	▲27.4%
CAR 車載機器	1,162	28.6%	1,226	32.4%	5.5%
MED 医療機器	31	0.8%	110	2.9%	254.8%
OTHER その他機器	1,769	43.6%	1,655	43.7%	▲6.4%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

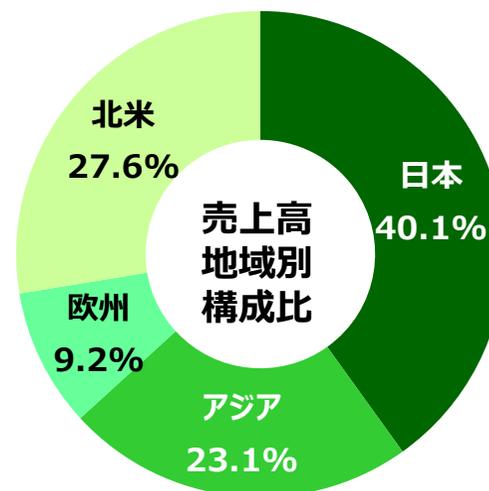
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含みます。

お客様から用途を開示頂けない製品は、その他機器に含めております。

2026年3月期 第1四半期業績 ～地域別売上高（フェニテック）



25.3期 1Q実績



26.3期 1Q実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	25.3期 1Q		26.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	1,583	39.0%	1,517	40.1%	▲4.2%
アジア	711	17.5%	875	23.1%	23.1%
欧州	331	8.2%	350	9.2%	5.7%
北米	1,434	35.3%	1,045	27.6%	▲27.1%
平均為替レート（1\$=）	156.5円		145.1円		

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2026年3月期 業績予想

26年3月期の業績予想に変更はありません

(単位：百万円)

	25.3期 通期実績	26.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率	備考
売上高	23,957	25,500	+6.4%	
営業損益	▲632	400	-	
営業利益率	▲2.7%	1.6%	-	
経常損益	▲820	400	-	
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲2,358	300	-	
EPS (円)	▲215.75	28.32	-	
平均為替レート (1\$=)	¥152.4	¥145.0	-	
減価償却費	2,468	2,000	▲19.0%	
設備投資	2,964	2,740	▲7.6%	

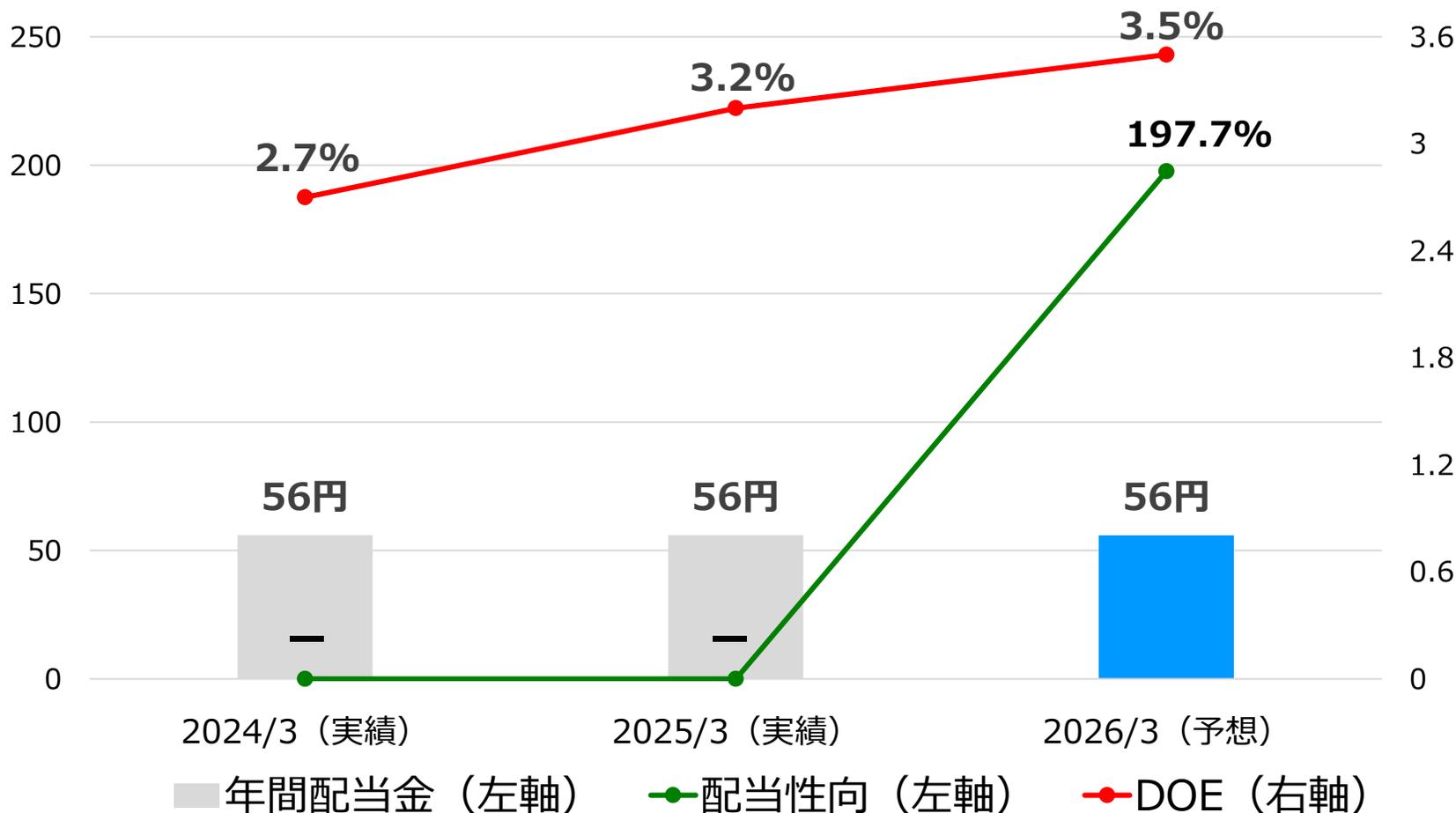
株主還元

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として
連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面
の目標として実施しております。

連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

配当金：円
配当性向：%

DOE：%



トピックス

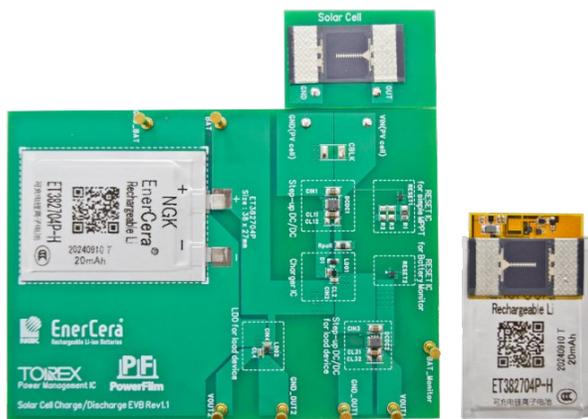
日本ガイシとトレックスは、有機薄膜太陽電池やペロブスカイト太陽電池などの次世代の太陽電池を搭載したEnerCera®充電モジュールを開発しました。

- ・ 発電電力をEnerCera®に充電しシステムへ供給
⇒ 100 μ W程度の弱い電力も無駄にしない



「EnerCera」シリーズ

Powerfilm 搭載基板



Solaires 搭載基板



ターゲットアプリケーション

- ・ウェアラブルデバイス
- ・IoTエッジデバイス
- ・工場／オフィスエッジデバイス
- ・室内環境モニタ

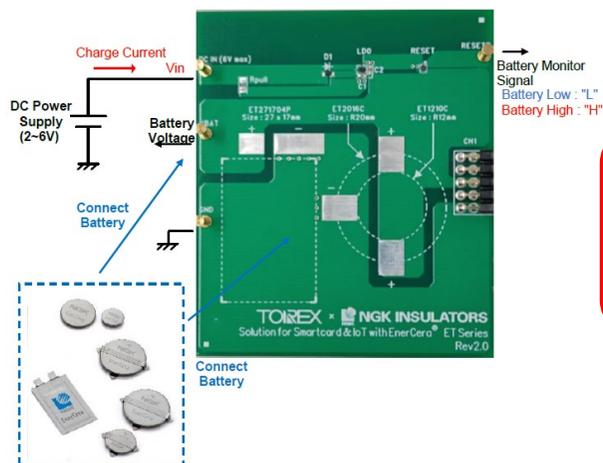
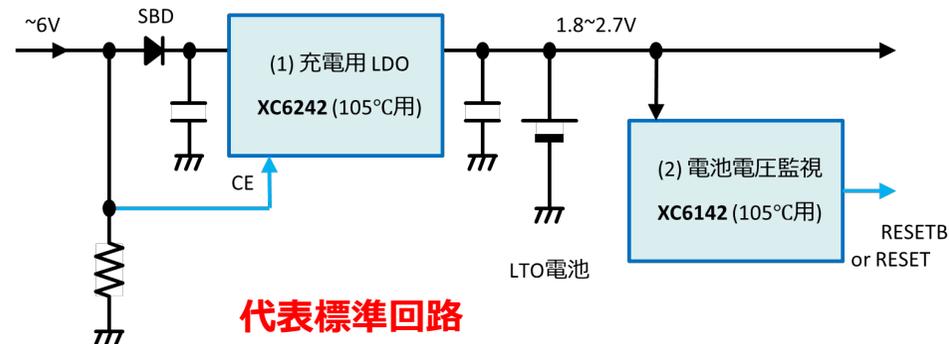
動作温度105°C 定電圧充電リチウム二次電池用 電圧検出器 XC6142シリーズ

製品の特長

- ・ 2.3V系 小型リチウム二次電池に最適化
- ・ 動作周囲温度：-40°C~105°C

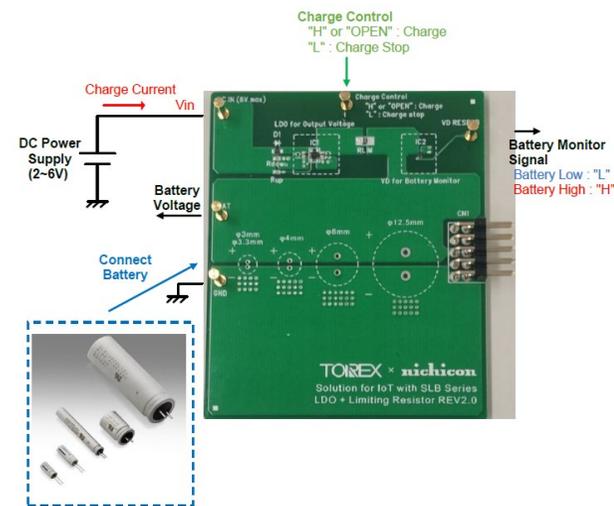
ターゲットアプリケーション

- CV充電対応二次電池の電圧監視
- 電気二重層コンデンサの電圧監視



NGK INSULATORS “EnerCera” ET シリーズ用 評価ボード

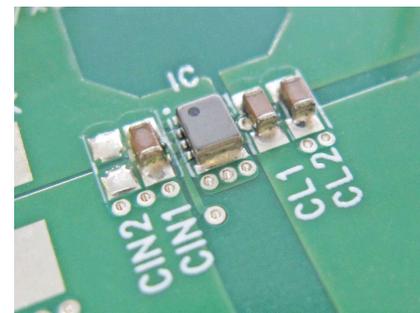
採用 リファレンス回路例
NGK EnerCeraシリーズ
Nichicon SLBシリーズ



Nichicon SLB シリーズ用 評価ボード

400nA 超低消費電流 PWM/PFM制御 コイル一体型 昇圧DC/DCコンバータ XCL108 シリーズ

- PWM/PFM自動切換制御
- 同期整流 ドライバ FET内蔵
- CL-2025-02 パッケージ



XCL108シリーズ 実装基板

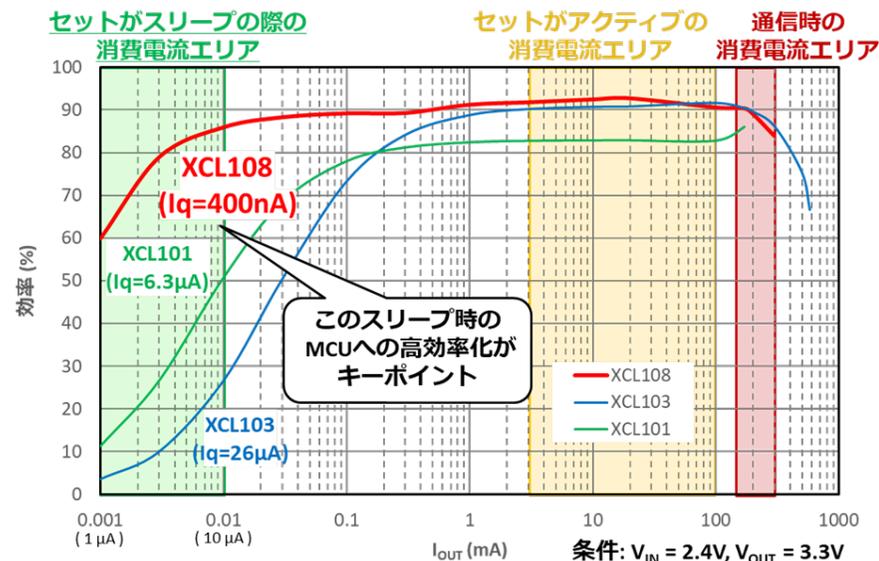
製品の特長

- 400nA 超低消費電流
- 発信周波数：1.2MHz
- 入力電圧範囲：0.65V ~ 5.5V
- 動作温度：-40℃ ~ 105℃
- 機能：電流制限、負荷切断、ソフトスタート

用途

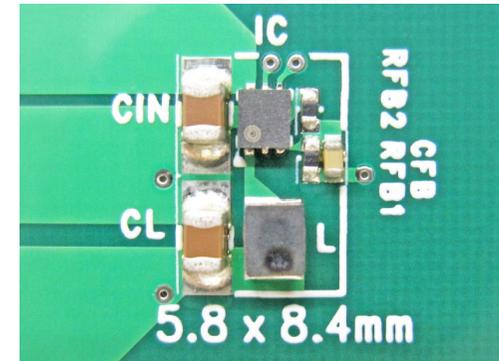
- 低電力無線通信機器、IoTモジュール
- 電池式医療機器／ウェアラブルデバイス
- リモコン、一次電池ポータブルデバイス
- 計量、スマートメーター（ガス/水道/温度）
- エナジーハーベスト

XCL108シリーズ 電力変換効率グラフ



PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XC9704/XC9705 シリーズ

- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ SOT-89-5、USP-6C



36V 600mA 降圧DC/DC
小型/低消費ソリューション

製品の特長

- ・ 高効率、低リップル電圧
- ・ 発信周波数：1.2MHz、2.2MHz
- ・ パワーグッド、UVLO、ソフトスタート外調
- ・ 電流制限、サーマルシャットダウン
- ・ 小型ソリューションを提供

ターゲットアプリケーション

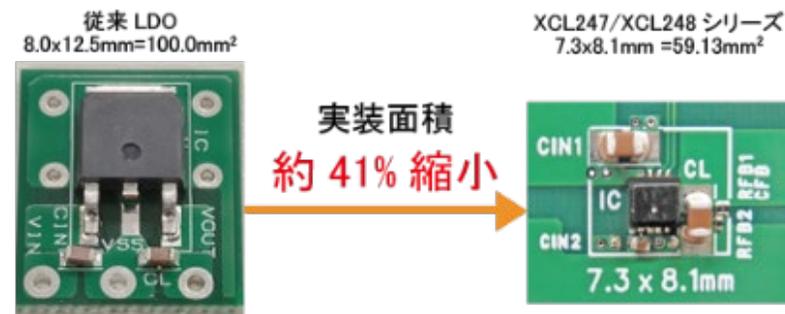
12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
工場・ビル・施設などのセンサ/セキュリティ機器
白物家電：エアコン等

<< 商談・採用事例 >>

- ・ 家庭用 エアコン
- ・ 業務用 エアコン、リモコン/コントローラ
- ・ 産業用カメラモジュール
- ・ FA用 各種センサー類
- ・ デジタル家電
- ・ 家電製品、白物家電

PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XCL247/XCL248 シリーズ

- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ 動作温度範囲 -40℃~105℃

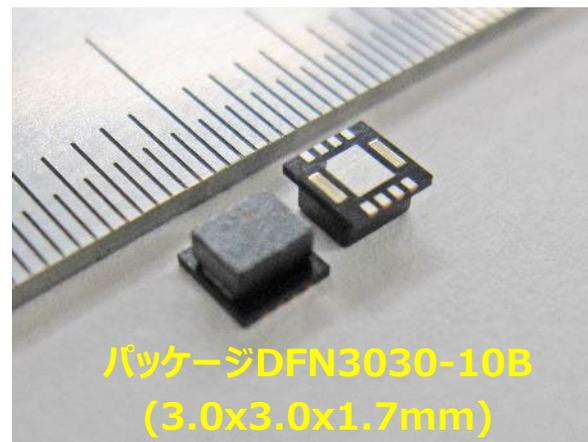


製品の特長

- ・ 徹底した小型化で約41%縮小（右図）
- ・ 電力変換の高効率化で発熱を大幅低減（右図）
- ・ ICの上部にコイルを実装する、トレックス独自のパッケージ採用で、超小型化を実現

ターゲットアプリケーション

- ・ 12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
- ・ FA機器、産業用センサー、セキュリティシステム、
- ・ 家電製品、高耐圧LDOの置き換え、等々



中国におけるサプライチェーンの現地化に対する顧客の需要の高まりに対応するため、トレックスはJETSEMIをパートナーとして選定しました。



JETSEMI

名称	深圳JET Semiconductor Technology Co., Ltd.
URL	http://www.jetsemi.com/

トレックスグループのメリット

トレックスの高信頼性電源管理IC製品ラインの中国における現地化を推進し、民生用電子機器、新エネルギー、産業オートメーションなどを含む中国市場におけるトレックス製品の採用を加速させます。



2月7日に半導体製品の世界的IDMメーカーであるPANJIT社と、当社の後工程を行うTVS社の持分の全部または一部を譲渡することを目的とする基本合意書を締結したことを発表。

名称	PANJIT INTERNATIONAL INC.
所在地	No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan
売上高 (2023年12月期)	12,707,319千台湾ドル (597億24百万円 / 1台湾ドル=4.7円換算)
資本金	3,821,149千台湾ドル
設立年月日	1986/05/20



トックスグループのメリット

PANJIT社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮。

パッケージ技術の高度化と全体的な競争力を向上



※同社IR資料より抜粋

フェニテックセミコンダクター

ファウンドリ受託

SiC

GaN

GaAs

Ga₂O₃

主要化合物半導体(SiC・GaN・GaAs・Ga₂O₃) デバイスの
ファウンドリをフレキシブルに受託できるのが、当社の“強み”です

ファウンドリ
Ga₂O₃

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 低スイッチング損失
- ✓ 低コスト基板製造の可能性

Ga₂O₃(酸化ガリウム)とは

酸化ガリウム半導体は、従来のシリコン半導体と比較して、より高い耐圧と低い電力損失を実現できます。ワイドバンドギャップであるため、高温や高周波環境下での動作にも優れています。また、他の次世代半導体材料に比べて、基板の製造コストを大幅に削減できる可能性があり、電力変換効率の向上やデバイスの小型化に貢献することが期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー社よりファウンドリを請け負い、
酸化ガリウムデバイスの試作生産を行なっています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 次世代パワー半導体材料として注目されるGa₂O₃の
ファウンドリにいち早く対応、今後Ga₂O₃デバイス開発
・生産の顧客ニーズに応え続けていきます

ファウンドリ SiC

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 高い電子移動度
- ✓ 高い熱伝導率
- ✓ 低いオン抵抗

SiC(炭化ケイ素)とは

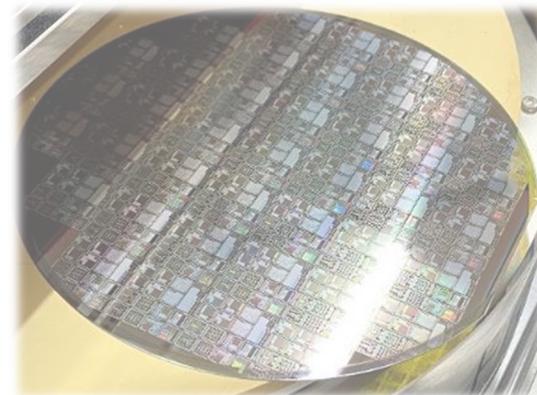
SiC半導体は、シリコンに対し高耐圧・高耐熱性、低損失、高速動作に優れます。これにより、電力変換効率が向上し、デバイスの小型化・軽量化が可能です。

応用分野は多岐に渡り、特に電気自動車のインバータやオンボードチャージャー、鉄道車両の駆動システム、産業機器のパワーコンディショナ、再生可能エネルギー分野などで実用化が進んでいます。高効率な電力制御を実現し、省エネルギー化に貢献する次世代パワー半導体として注目されています。

- ・ 当社SiCファウンドリは、SBD,MOSFET以外にも、要素開発・試作フェーズのものを含めると様々な製品の生産を担っています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 今後も、ますます増えていくSiCデバイス生産の顧客ニーズにフレキシブルに応え続けていきます

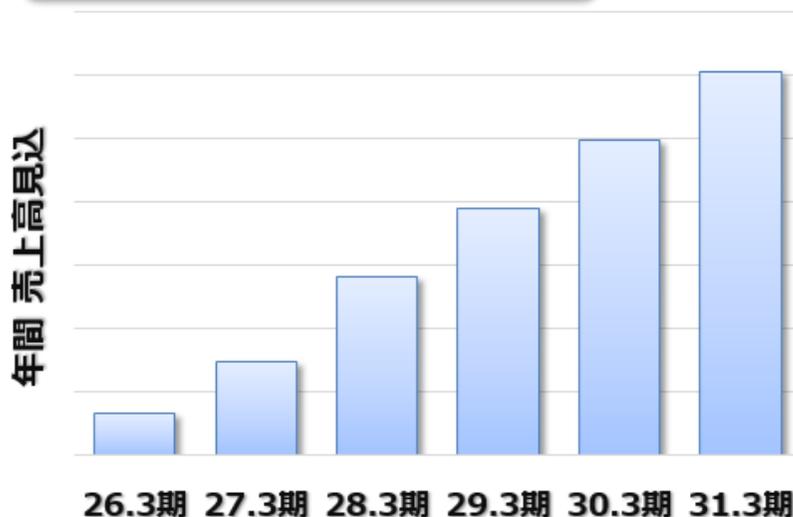


ファウンドリ受託

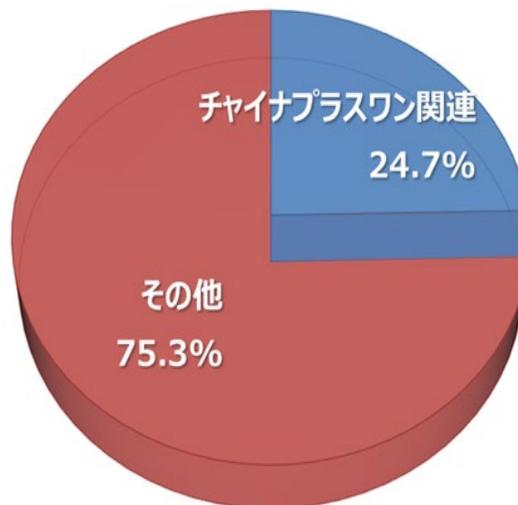
新規受注案件

- ✓ 小信号ディスクリート、TVS、パワーデバイスを中心に多種製品の受注があり、幅広い製品受託が可能な当社の“強み”が市場に支持されています
- ✓ 中華圏企業のチャイナプラスワン戦略や、不安定な市場環境の中、30年以上の歴史を誇る当社ファウンドリ事業の安定性が支持され、受注が増加しています

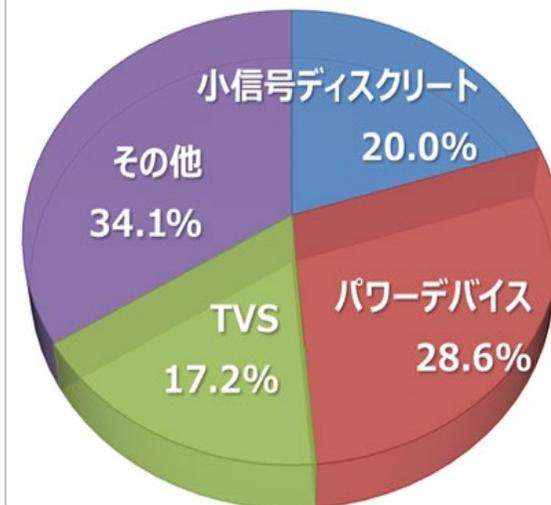
新規受注案件 売上高見込み



「チャイナプラスワン」関連比率



新規受注案件製品比率



- ▶ 当社は、中国一極集中を避け生産拠点を分散する各社のリスクヘッジ戦略は続くと見込み、チャイナプラスワン戦略関連案件を積極的に取り込みます
- ▶ 受託可能な幅広い製品受託を推進する全方位戦略を敷き、今後もあらゆる可能性を新規受注に繋げていきます

Si製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

Low Vth MOSFET **量産中**

- ・製品ラインナップ拡充を継続

スプリットゲート型MOSFET

60V プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q3 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

100V

150V

SiC製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

SBD

自社開発品

量産フェーズ

650V 10A Gen.2,3

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中 26.3期Q3量産予定
- ・目標耐圧2200V,3300V品を開発中

MOS FET

自社開発品

1200V 20A Planar/Trench

1200V 40A Planar

1200V 80A Planar

✓電流ラインナップシリーズ展開 試作中

プレーナー型

- ・サンプル提供中/顧客評価中 27.3期Q1量産予定
- ・ベースプロセスライン完成 ラインナップ化を進める
(1200V 40A /1200V 80A)

トレンチ型

- ・開発中

広島大学 学長定例記者会見

2025.04.24

会見概要

当社は、広島大学との共同研究により、高温や高放射線環境下で動作する半導体チップを鹿児島工場にて試作製造し、広島大学で行われた記者会見で、共同研究の成果として発表しました。

この半導体チップは、SiC(炭化ケイ素)を使用した集積回路で、SiC集積回路の量産ファブでの試作製造は、世界初の取組みとなります。

デバイス設計は主に広島大学が担当し、製造プロセス検討を合同で行い、鹿児島工場6インチ量産ファブで生産しました。

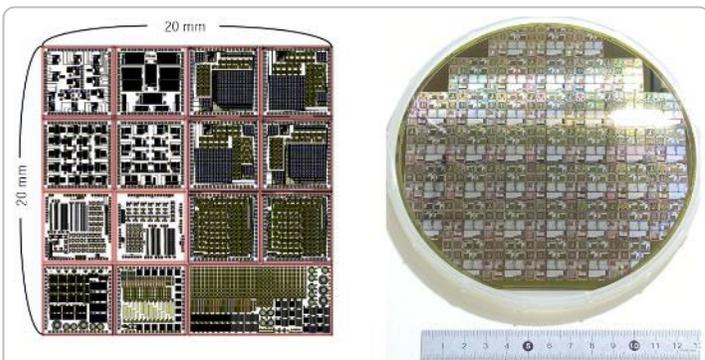
1年弱という短期間で試作ウェハーを完成することができました。今後は幅広い分野での利用を期待し、量産準備を進めます。



広島大学学長定例記者会見の様子
左は広島大学 黒木副所長
右は当社代表取締役 石井(陪席者として登壇)



成果の内容



左は試作製造された集積回路などの図面
右は試作製造されたSiCウェハー

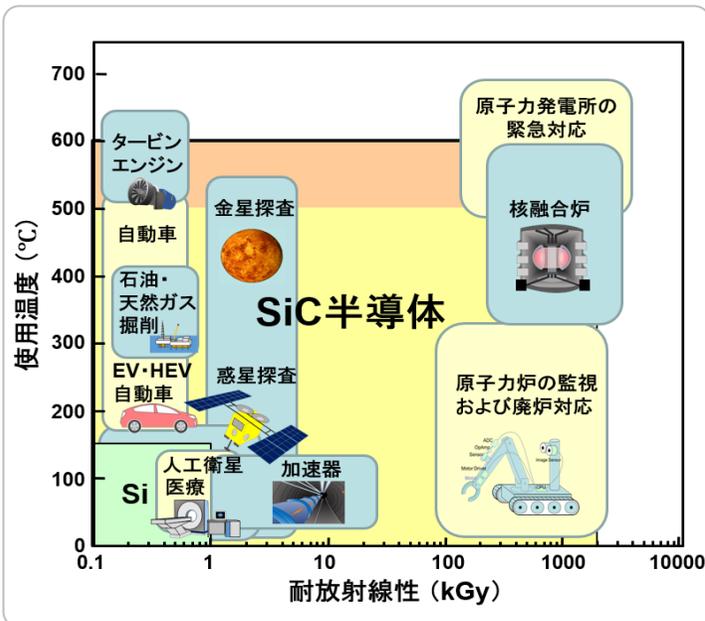
合同チームにより、新たにSiC集積回路専用の製造プロセスを新たに構築

試作製造したSiC集積回路は、500℃の高温や高い放射線量の中でも動作

シリコン半導体チップの一般的制限 最大温度 150℃、耐放射線性1kGry(キロ・グレイ)程度を越え、半導体の利用領域を大幅に広げる

応用分野はシリコン半導体が使用できない領域

EV、原発の廃炉作業、粒子線医療、宇宙開発、次世代原子炉・核融合炉など



今後は...

- ✓ SiC集積回路設計・製造の環境整備
- ✓ SiC集積回路の大規模化
- ✓ 応用分野システムメーカーとの連携・ファウンドリ立ち上げの為にSiC集積回路の共通プラットフォーム構築へ

SEMICON Japan 2025

中四国パビリオン

初出展

✓ 次回セミコンジャパン2025 中四国パビリオン に出展します

開催日

2025年12月17日(水) ~ 19日(金)

会場

東京ビッグサイト 西1ホール

第40回 ネプコン ジャパン

- エレクトロニクス開発・実装展 -

第40回 インターネプコン ジャパン

- エレクトロニクス製造・実装展 -

✓ 次回ネプコンジャパン EMS/製造受託ゾーン に出展します

開催日

2026年1月21日(水) ~ 23日(金)

会場

東京ビッグサイト 東5ホール E8-38

今期は、継続出展となるネプコンジャパンに加え、セミコンジャパンにも初出展いたします。双方の展示会出展により、SiC-化合物-Siファウンドリ企業としての魅力を、広く発信してまいります。



前回出展時 当社ブースの様子

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること



Appendix 会社紹介

1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

アナログのチカラ

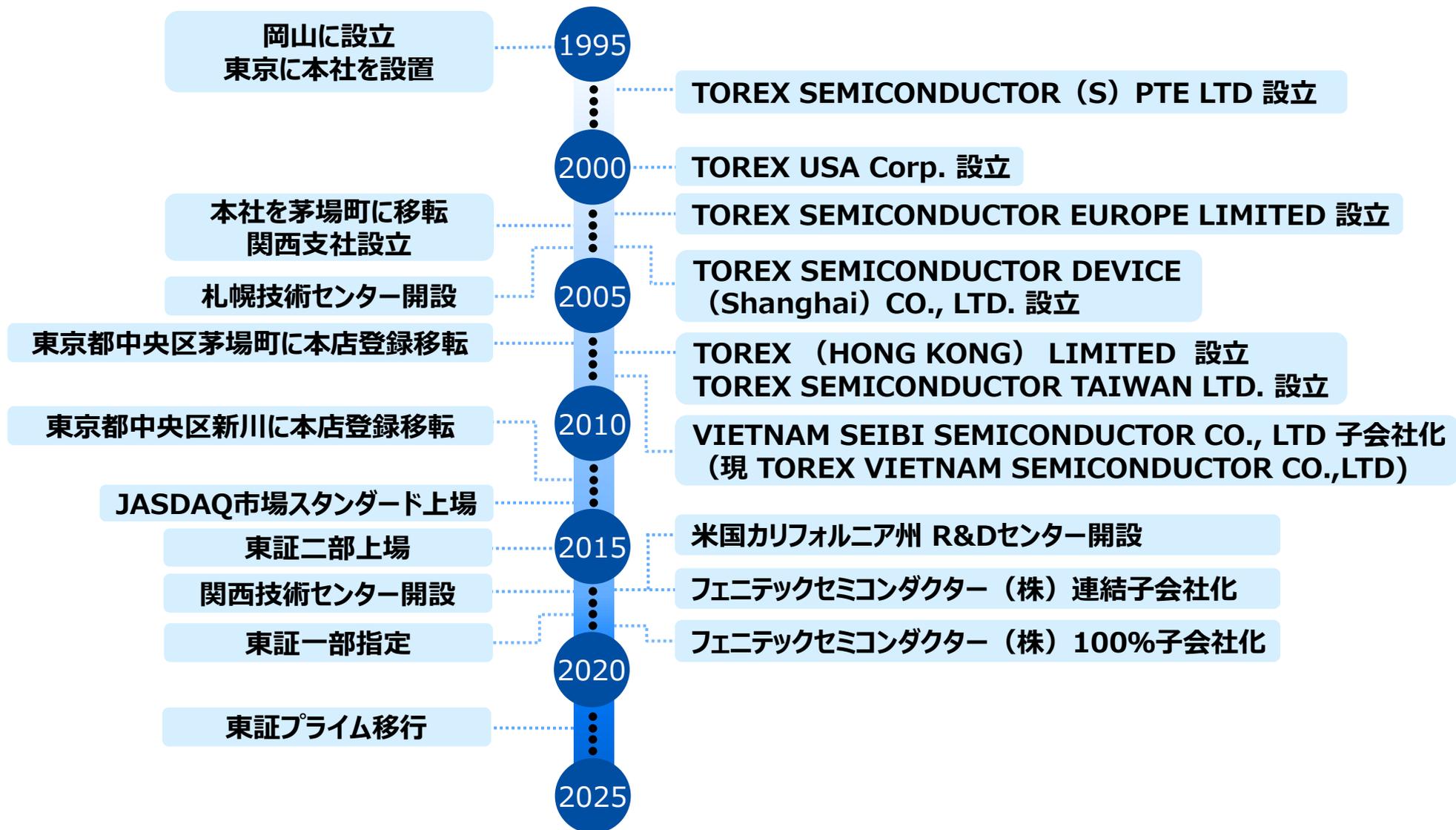
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2025年6月30日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：188名 / グループ：1,046名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー
アナログ電源IC専業**

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitex
For Further Growth Together



フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)
ディスクリート、パワーデバイス、
CMOSアナログプロセス**

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



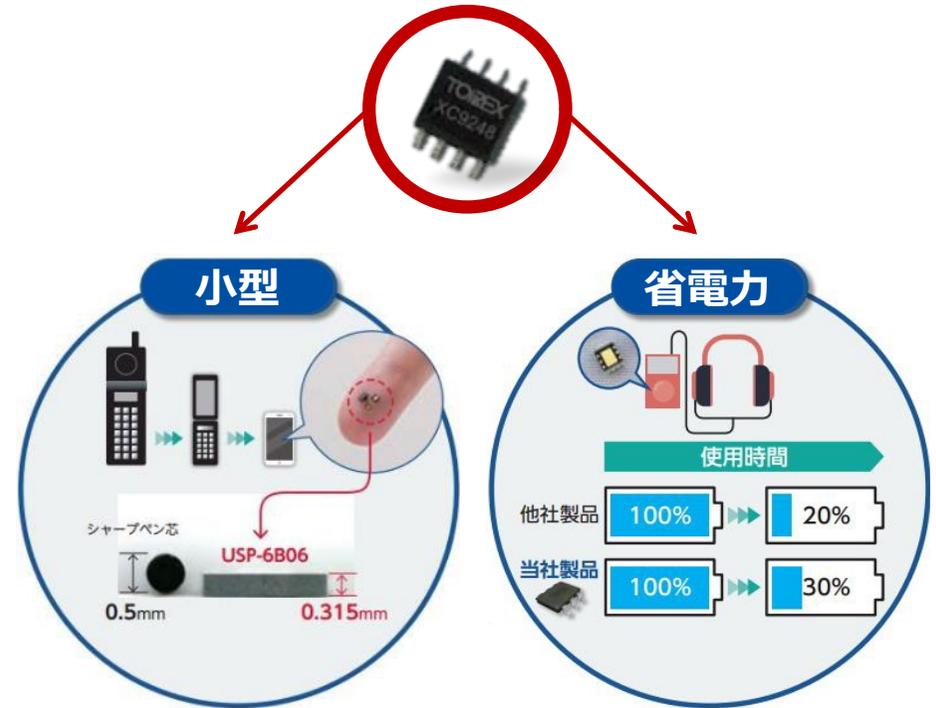
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;">省エネに貢献するキーデバイスを提供</p> <p>電源IC</p>	<p>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</p>
今後の重点市場	<p>産業機器 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p>車載機器 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p>産業機器 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p>車載機器 EV向けパワー半導体 電装品</p>



5G



IoT



自動運転



EV

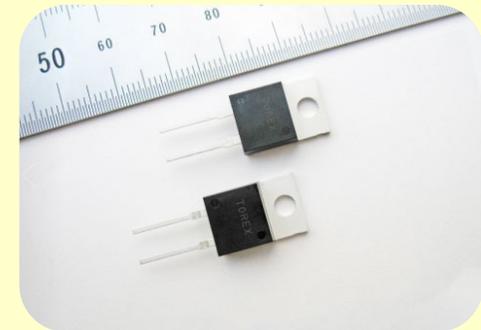
● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

パワー半導体事業拡大の専任組織を設置し、強かに推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低V_{th}製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
 - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供中
 - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
 - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を推進しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)

トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

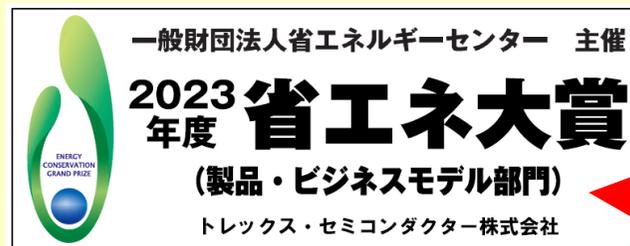
2023年度



日刊工業新聞主催

XC9145シリーズ：昇圧DC/DCコンバータ
回路の消費電流を400nAまで低減したPWM/PFM制御方式を採用することで、軽負荷時、特に数 μ Aの出力電流における電力効率を50~60%改善しました。

奨励賞
受賞



トレックス・セミコンダクター株式会社

審査委員会
特別賞受賞

XC8110/8111シリーズ：ロードスイッチIC
理想的なダイオードを再現し、チップイネーブル(CE)、過電流制限、突入電流制限、サーマルシャットダウン機能等を搭載したロードスイッチICです。

2022年度



日刊工業新聞主催

XC8110/8111シリーズ
ロードスイッチIC

2020年度



省エネルギーセンター主催

XC9276シリーズ
DC/DCコンバータ

2019年度



日刊工業新聞主催

XC9281/XC9282シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



経済産業省主催

XC9265シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



日刊工業新聞主催

XC6192シリーズ
ロードスイッチIC

プライム市場の上場維持基準への適合状況

当社は、2025年3月31日時点において、東京証券取引所プライム市場における上場維持基準について、下記のとおり不適合が生じておりますことをお知らせいたします。

上場維持基準6項目のうち5項目は満たしているものの、「流通株式時価総額」が81.2億円と基準値100億円以上を充たしておりません。

当社は、流通株式時価総額の基準に関し、上場維持基準を充たすべく、各種取組みを進めて参ります。

	株主数	流通株式数	流通株式時価総額	流通株式比率	1日平均売買代金	純資産の額
当社の状況 (基準日時点)	3,842人	66,611 単位	81.2億円	57.6%	5千176万円	174億円
上場維持基準	800人 以上	20,000 単位以上	100億円 以上	35%以上	2千万円 以上/日	純資産の額が 正
適合状況	適合	適合	不適合	適合	適合	適合

時価総額

×

流通株式比率

=

流通株式時価総額

上場維持基準の未達項目である「流通株式時価総額」の充足に向けて、収益性を改善することを背景として株価を上昇させ、「時価総額」を向上させることで、2026年3月期末日までに未達項目の適合を目指します。

主要製品である電源ICの売上及びディスクリート製品のファウンドリ売上拡大による収入の拡大に注力するとともに、高付加価値製品の販売強化による収益率の改善、社内改善活動による経費の低減を進め、収益性の向上を行います。

また、今年度中には2026年度から始まる新たな中期経営計画を策定し、中長期の成長戦略やサステナビリティ情報、資本コストを意識した経営に関する情報等の開示することで、株式バリュエーションの上昇にも取り組んでまいります。

本資料に記載された内容は、2025年8月12日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。